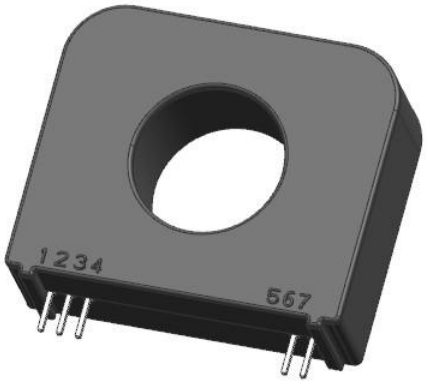
SED-LCM系列交流/直流漏电流传感器是一种新型开环磁通门电流传感器，应用磁通门磁调制原理，在微电流测量中具有良好的稳定性，在一次和二次电路之间具有高度的电流隔离。

优势特征：

- 应用开环磁通门原理的漏电流传感器
- 单电源5V供电
- 额定测量电流范围：0.3~1A
- 传感器工作温度范围：-40 °C to +85°C
- 高精度，低零漂，响应快
- 具有自检功能



产品应用：

- 直流系统漏电流检测
- 接地故障检测
- 交流充电桩
- 光伏逆变器

命名规则：

SED-0.3LCM

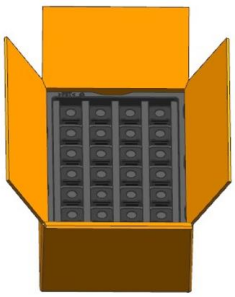
① ② ③ （示例）

① SED：漏电流传感器

② 额定测量电流=0.3A

③ LCM 系列

包装信息：



240pcs/box

10-tray/box

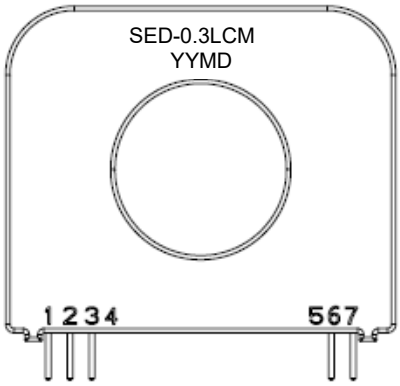
24pcs/tray

订货信息：

型号	额定测量电流 I_{PN} (A)	额定输出电压 V_{OUT} (V)	测量电流 I_{PM} (A)	灵敏度 V/A	MPQ (PCS)	MOQ (PCS)
SED-0.3LCM	0.3	3.7	0.5	4.0	240	240
SED-0.6LCM	0.6		1.0	2.0		
SED-1.0LCM	1.0		1.667	1.2		

上海深启半导体科技有限公司保留为改进其传感器的性能和可靠性，而对规格书进行修正的权利，恕不另行通知。
公司地址：上海市都会路 2059 号 G 幢 2 楼

产品打标信息:



打标信息说明：

SED-0.3LCM：产品型号（具体以实际型号为准）

YYMD：YY-生产年份

M—生产月份，A 代表 10 月，B 代表 11 月

D—生产日期，A 代表 10 号，K 代表 20 号

机械参数:

- 外壳材质 PBT+GF30
- 重量 20 g±5%

基本参数

Parameter	Symbol	Value	Unit
最大供电电压	VCC_{MAX}	+6	V
工作温度范围	T_A	-40 to 105	°C
存储温度范围	T_S	-40 to 105	°C
CTI 值	CTI	600	V
爬电距离	d_{CP}	12	mm
电气间隙	d_{CL}	12	mm
交流耐压试验：有效值电压，50 Hz， 1 分钟	V_{ISO}	5	KV
冲击耐受电压 1.2/50 微秒	V_{Ni}	10	KV
局部放电有效值试验电压	V_t	1.65	KV
应用实例 加强绝缘，CAT III，依据 EN 50178 标准、非均匀电场下的 PD2	-	1000	V
应用实例 加强绝缘，CAT III，依据 EN 50178、IEC 61010 标准，非均匀电场下的 PD3	-	600	V

电气参数

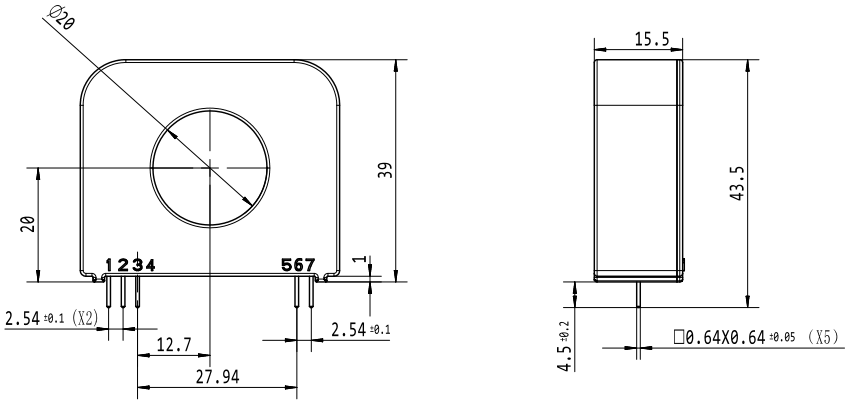
Parameter	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
供电电压（±5%）	V_{CC}		+5		V
供电电流	I_{CC}		20		mA
零点输出电压	Vo		2.5		V
内部参考电压	V_{ref_out}	2.495	2.5	2.505	V
外部参考电压	V_{ref_in}	2.3		4	V
输出电压	V_{OUT}		$=2.5+2*I/I_{PM}$		V
自检电流	I_check		50		mA
原边过流能力	I_{MAX}			20	A
带宽 （-3dB）	BW		700		Hz

上海深启半导体科技有限公司保留为改进其传感器的性能和可靠性，而对规格书进行修正的权利，恕不另行通知。
公司地址：上海市都会路 2059 号 G 幢 2 楼

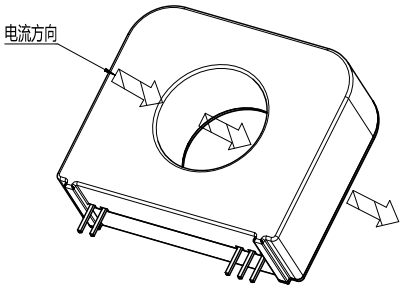
精度-动态表现参数

Parameter	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
输出误差@±I_{PN} @25℃	X		±2		%
输出误差@±I_{PN} @105℃	X_T		±3		%
线性度误差（0…±I_{PN}）	ε_L	-1	0.6	1	% of I_{PN}
零点输出误差	V_{OE}		±20		mV
零点温度漂移@-40~105℃	TCVOE		±400		ppm/k of 2.5V
灵敏度温度漂移@-40~105℃	TCG		±375		ppm/℃

产品图纸



PINS	
1	M
2	CHK
3	G
6	+5V
7	Vref



注意事项:

1. 错误的接线可能导致传感器损坏。传感器接+5V 电源后，被测电流从传感器箭头方向穿过，即可在输出端测得相对应的电压值。
2. 存储条件：储存温度≤30℃，储存湿度30-60%
3. 保存期限：产品均采用真空包装，包装无破损情况下，从出厂日期开始算，镀锡部件储存期限为6个月；拆包装后或真空包装漏气，请在3个月内尽快使用；超过以上时间，且存储条件无法保证，建议使用前做可焊性实验。
4. 自检电压推荐3.3V-5V

版本号	变更内容	变更日期
V1.0	初版	2022/11/01
V1.1	更新图纸及规格书模板	2026/03/18

上海深启半导体科技有限公司
生效 2026-03-19 日期
受 控 文 件

上海深启半导体科技有限公司保留为改进其传感器的性能和可靠性，而对规格书进行修正的权利，恕不另行通知。
公司地址：上海市都会路 2059 号 G 幢 2 楼